



App. No. 10/604,133
Priority Document Submission

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

App. No. : 10/604,133
Applicant : Masuhiro Natsuhara et al.
Filed : June 27, 2003
Title : **WAFER HOLDER FOR SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING DEVICE AND
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING DEVICE IN
WHICH IT IS INSTALLED**

Tech. Cntr./Art Unit : (To be assigned)
Examiner : (To be assigned)

Docket No. : 39.017-AG

Honorable Commissioner of Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

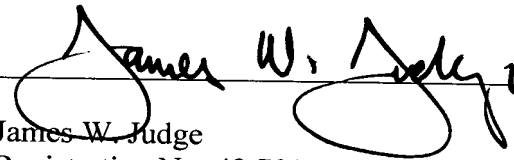
**Submission of Documents in Claiming Priority Right
Under 35 U.S.C. § 1.119(b)**

Sir:

To complete the claim made for the benefit of an earlier foreign filing date on filing the application identified above, Applicant herewith submits a certified copy of **Japanese Patent Application No. JP2003-064279, filed March 11, 2003.**

Respectfully submitted,

July 7, 2003


James W. Judge
Registration No. 42,701

JUDGE PATENT FIRM
Rivière Shukugawa 3rd Fl.
3-1 Wakamatsu-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo 662-0035
JAPAN
Telephone: 800-784-6272
Facsimile: 425-944-5136
e-mail: jj@judgepat.jp

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2003年 3月11日

出願番号

Application Number:

特願2003-064279

[ST.10/C]:

[JP2003-064279]

出願人

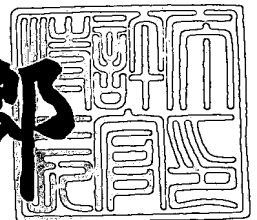
Applicant(s):

住友電気工業株式会社

2003年 5月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3032829

【書類名】 特許願

【整理番号】 103I0046

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 3/10
H05B 3/20

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目 1 番 1 号 住友電気工業株式
会社伊丹製作所内

【氏名】 夏原 益宏

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目 1 番 1 号 住友電気工業株式
会社伊丹製作所内

【氏名】 仲田 博彦

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目 1 番 1 号 住友電気工業株式
会社伊丹製作所内

【氏名】 橋倉 学

【特許出願人】

【識別番号】 000002130

【氏名又は名称】 住友電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100102691

【弁理士】

【氏名又は名称】 中野 稔

【選任した代理人】

【識別番号】 100111176

【弁理士】

【氏名又は名称】 服部 保次

【選任した代理人】

【識別番号】 100112117

【弁理士】

【氏名又は名称】 山口 幹雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100116366

【弁理士】

【氏名又は名称】 二島 英明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008224

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0114173

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体製造装置用ウェハ保持体およびそれを搭載した半導体製造装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ウェハ搭載面を有するウェハ保持体において、前記ウェハ保持体を支持するシャフトが前記ウェハ保持体に接合されており、前記ウェハ保持体のウェハ搭載面以外の表面もしくは内部に形成された電気回路に給電するための電極の前記シャフト内における熱容量が、前記ウェハ保持体のシャフトの外周部内に相当する部分の熱容量の 1 0 % 以下であることを特徴とする半導体製造装置用ウェハ保持体。

【請求項 2】 前記ウェハ保持体に形成された電気回路が、少なくとも抵抗発熱体であることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体製造装置用ウェハ保持体。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 に記載のウェハ保持体が搭載されていることを特徴とする半導体製造装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、プラズマ CVD、減圧 CVD、メタル CVD、絶縁膜 CVD、イオン注入、エッチング、Low-K 成膜、DEGAS 装置などの半導体製造装置に使用されるウェハ保持体、更にはそれを搭載した処理チャンバー、半導体製造装置に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来、半導体の製造工程では、被処理物である半導体基板に対して成膜処理やエッチング処理など様々な処理が行われる。このような半導体基板に対する処理を行う処理装置では、半導体基板を保持し、半導体基板を加熱するためのセラミックヒータが用いられている。

【 0 0 0 3 】

このような従来のセラミックスヒータは、例えば特開平4-78138号公報に開示されている。特開平4-78138号公報に開示されたセラミックスヒータは、抵抗発熱体が埋設され、容器内に設置され、ウェハー加熱面が設けられたセラミックス製のヒータ部と、このヒータ部のウェハー加熱面以外の面に設けられ、前記容器との間で気密性シールを形成する凸状支持部と、抵抗発熱体へと接続され、容器の内部空間へと実質的に露出しないように容器外へ取り出された電極とを有する。

【0004】

この発明では、それ以前のヒータである金属製のヒータで見られた汚染や、熱効率の悪さの改善が図られているが、半導体基板の温度分布については触れられていない。しかし、半導体基板の温度分布は、前記様々な処理を行う場合に、歩留りに密接な関係が生じるので重要である。そこで、例えば特開2001-118664号公報では、セラミック基板の温度を均一化することができるセラミックヒータが開示されている。この発明では、セラミック基板面の最高温度と最低温度の温度差は、数%以内であれば、実用に耐えるとされている。

【0005】

しかし、近年の半導体基板は大型化が進められている。例えば、シリコン(Si)ウェハでは8インチから12インチへと移行が進められている。この半導体基板の大口径化に伴って、セラミックスヒータの半導体基板の加熱面(保持面)の温度分布は、 $\pm 1.0\%$ 以内が必要とされるようになり、更には、 $\pm 0.5\%$ 以内が望まれるようになってきた。

【0006】

【特許文献1】

特開平04-078138号公報

【特許文献2】

特開2001-118664号公報

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記問題点を解決するためになされたものである。すなわち、本発

明は、ウェハ保持面の均熱性を高めた半導体製造装置用ウェハ保持体およびそれを搭載した半導体製造装置を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

前記特許文献1に記載の半導体製造装置用ウェハ保持体は、ヒータ回路で発生した熱が、電極に伝わり、その結果、電極直上のウェハ搭載面の温度が相対的に低下するためにウェハ保持体のウェハ搭載面の温度分布が不均一になることを見出し、本発明に至った。

【0009】

すなわち、本発明は、ウェハ搭載面を有するウェハ保持体において、前記ウェハ保持体のウェハ搭載面以外の表面もしくは内部に形成された電気回路に給電するための電極の前記シャフト内における熱容量が、前記ウェハ保持体のシャフトの外周部内に相当する部分の熱容量の10%以下である。より好ましくは、5%以下である。前記ウェハ保持体に形成された電気回路は、少なくとも抵抗発熱体であることが望ましい。

【0010】

上記のようなウェハ保持体を搭載した半導体製造装置は、被処理物であるウェハの温度が従来のもものより均一になるので、歩留り良く半導体を製造することができる。

【0011】

【発明の実施の形態】

発明者は、ウェハ保持面の温度分布を±1.0%以内にするためには、ウェハ保持体(1)に形成された電気回路(3)に給電するための電極(2)のシャフト(4)内における熱容量を、ウェハ保持体のシャフトの外周部内に相当する部分(5)の熱容量の10%以下にすれば良いことを見出した。

【0012】

ここで、電気回路は、ウェハ保持体を加熱するための抵抗発熱(ヒータ)回路、あるいはプラズマを発生させるためのRF電極回路、更にはウェハを静電的に保持するための静電チャック回路などがある。これらの電気回路は、少なくと

も抵抗発熱体回路を具備することが好ましく、同時にその他の回路を具備していてもよい。また、これらの電気回路に給電するための電極（２）は、図２に示すように前記シャフト（４）内に配置されている。

【 0 0 1 3 】

ウェハ保持体は、その内部もしくはウェハ搭載面以外の表面に形成した抵抗発熱体（３）によってウェハを加熱し、ウェハに所定の処理を施す。しかし、前記電極のシャフト内における熱容量が、ウェハ保持体のシャフトに相当する部分の熱容量の１０％を超えると、抵抗発熱体で発生した熱が、電極を介して逃げ易くなるので、ウェハ保持面の温度分布が不均一となりやすい。ウェハ搭載面の温度が部分的に低下すると、搭載したウェハの温度も部分的に低下するので、例えばウェハに成膜処理を施す場合には形成した膜の厚みや性質がばらつくことになる。また、例えばエッチング処理の場合には、エッチング速度がばらつくことになる。

【 0 0 1 4 】

このため、ウェハ表面の温度分布は少なければ少ないほどよいが、現状では、温度分布は±１．０％以内の均熱性、望むべくは±０．５％以内の均熱性が求められている。このような均熱性を得るためには、電極のシャフト内における熱容量をウェハ保持体のシャフトに想到する部分の熱容量の１０％以下にすればよいことを見出した。

【 0 0 1 5 】

セラミックスヒータによって発熱された熱は、ウェハ搭載面を加熱するだけでなく、ウェハ搭載面以外の面や、セラミックスヒータに接続された電極にも放散される。この時、シャフト内の電極に伝わる熱量が大きいと、電極の直上部のウェハ搭載面の温度が低下する。また、シャフト内は、チャンバー内の雰囲気とは独立しており、通常常圧であるので、対流による熱の移動が可能である。そのため、シャフト内の電極への熱の移動は、ウェハ搭載面の温度低下に大きな影響を与える。

【 0 0 1 6 】

このシャフト内の電極への熱の移動量は、電極の数が多かったり、電極の体積

が大きいと、多くなる。すなわち、電極のシャフト内における熱容量が大きい程、電極への熱の移動量が多くなり、ウェハ搭載面の温度分布が大きくなる。ウェハ搭載面の温度分布が大きくなれば、搭載したウェハ表面の温度分布も大きくなる。このため、ウェハ表面の温度分布を $\pm 1.0\%$ 以内の均熱性にしようとすれば、シャフト内における電極の熱容量を、ウェハ保持体のシャフトに相当する部分の熱容量の 10% 以下とすればよい。更に、 5% 以下であれば、ウェハ搭載面の温度分布を $\pm 0.5\%$ 以下の均熱性にできるので好ましい。

【0017】

なお、シャフト内における電極の熱容量とは、電極がシャフトより短い場合は、電極全体の熱容量であるが、電極がシャフトより長い場合は、電極のシャフト端部までの熱容量である。また、電極が複数形成されている場合は、複数の電極の合計の熱容量である。

【0018】

本発明のウェハ保持体の材質については、絶縁性のセラミックスであれば特に制約はないが、熱伝導率が高く、耐食性にも優れた窒化アルミニウム（AlN）が好ましい。以下に、本発明のウェハ保持体の製造方法をAlNの場合で詳述する。

【0019】

AlNの原料粉末は、比表面積が $2.0 \sim 5.0 \text{ m}^2/\text{g}$ のものが好ましい。比表面積が $2.0 \text{ m}^2/\text{g}$ 未満の場合は、窒化アルミニウムの焼結性が低下する。また、 $5.0 \text{ m}^2/\text{g}$ を超えると、粉末の凝集が非常に強くなるので取扱いが困難になる。更に、原料粉末に含まれる酸素量は、 $2 \text{ wt}\%$ 以下が好ましい。酸素量が $2 \text{ wt}\%$ を超えると、焼結体の熱伝導率が低下する。また、原料粉末に含まれるアルミニウム以外の金属不純物量は、 2000 ppm 以下が好ましい。金属不純物量がこの範囲を超えると、焼結体の熱伝導率が低下する。特に、金属不純物として、SiなどのIV族元素や、Feなどの鉄族元素は、焼結体の熱伝導率を低下させる作用が高いので、含有量は、それぞれ 500 ppm 以下であることが好ましい。

【0020】

AlNは難焼結性材料であるので、AlN原料粉末に焼結助剤を添加することが好ましい。添加する焼結助剤は、希土類元素化合物が好ましい。希土類元素化合物は、焼結中に窒化アルミニウム粉末粒子の表面に存在するアルミニウム酸化物あるいはアルミニウム酸窒化物と反応して、窒化アルミニウムの緻密化を促進するとともに、窒化アルミニウム焼結体の熱伝導率を低下させる原因となる酸素を除去する働きもあるので、窒化アルミニウム焼結体の熱伝導率を向上させることができる。

【 0 0 2 1 】

希土類元素化合物は、特に酸素を除去する働きが顕著であるイットリウム化合物が好ましい。添加量は、0.01～5wt%が好ましい。0.01wt%未満であると、緻密な焼結体を得ることが困難であるとともに、焼結体の熱伝導率が低下する。また、5wt%を超えると、窒化アルミニウム焼結体の粒界に焼結助剤が存在することになるので、腐食性雰囲気中使用する場合、この粒界に存在する焼結助剤がエッチングされ、脱粒やパーティクルの原因となる。更に、好ましくは焼結助剤の添加量は、1wt%以下である。1wt%以下であれば、粒界の3重点にも焼結助剤が存在しなくなるので、耐食性が向上する。

【 0 0 2 2 】

また、希土類元素化合物は、酸化物、窒化物、フッ化物、ステアリン酸化合物などが使用できる。この中で、酸化物は安価で入手が容易であり好ましい。また、ステアリン酸化合物は、有機溶剤との親和性が高いので、窒化アルミニウム原料粉末と焼結助剤などを有機溶剤で混合する場合には、混合性が高くなるので特に好適である。

【 0 0 2 3 】

次に、これら窒化アルミニウム原料粉末や焼結助剤粉末に、所定量の溶剤、バインダー、更には必要に応じて分散剤や邂逅剤を添加し、混合する。混合方法は、ボールミル混合や超音波による混合等が可能である。このような混合によって、原料スラリーを得ることができる。

【 0 0 2 4 】

得られたスラリーを成形し、焼結することによって窒化アルミニウム焼結体を

得ることができる。その方法には、コファイアー法とポストメタライズ法の２種類の方法が可能である。

【 0 0 2 5 】

まず、ポストメタライズ法について説明する。前記スラリーをスプレードライアー等の手法によって、顆粒を作成する。この顆粒を所定の金型に挿入し、プレス成形を施す。この時、プレス圧力は、 0.1 t/cm^2 以上であることが望ましい。 0.1 t/cm^2 未満の圧力では、成形体の強度が十分に得られないことが多く、ハンドリングなどで破損し易くなる。

【 0 0 2 6 】

成形体の密度は、バインダーの含有量や焼結助剤の添加量によって異なるが、 1.5 g/cm^3 以上であることが好ましい。 1.5 g/cm^3 未満であると、原料粉末粒子間の距離が相対的に大きくなるので、焼結が進行しにくくなる。また、成形体密度は、 2.5 g/cm^3 以下であることが好ましい。 2.5 g/cm^3 を超えると、次工程の脱脂処理で成形体内のバインダーを充分除去することが困難となる。このため、前述のように緻密な焼結体を得ることが困難となる。

【 0 0 2 7 】

次に、前記成形体を非酸化性雰囲気中で加熱し、脱脂処理を行う。大気等の酸化性雰囲気では脱脂処理を行うと、AlN粉末の表面が酸化されるので、焼結体の熱伝導率が低下する。非酸化性雰囲気ガスとしては、窒素やアルゴンが好ましい。脱脂処理の加熱温度は、 500°C 以上、 1000°C 以下が好ましい。 500°C 未満の温度では、バインダーを充分除去することができないので、脱脂処理後の積層体中にカーボンが過剰に残存するので、その後の焼結工程での焼結を阻害する。また、 1000°C を超える温度では、残存するカーボンの量が少なくなり過ぎるので、AlN粉末表面に存在する酸化被膜の酸素を除去する能力が低下し、焼結体の熱伝導率が低下する。

【 0 0 2 8 】

また、脱脂処理後の成形体中に残存する炭素量は、 $1.0 \text{ wt}\%$ 以下であることが好ましい。 $1.0 \text{ wt}\%$ を超える炭素が残存していると、焼結を阻害するので、緻密な焼結体を得ることができない。

【 0 0 2 9 】

次いで、焼結を行う。焼結は、窒素やアルゴンなどの非酸化性雰囲気中で、1700～2000℃の温度で行う。この時、使用する窒素などの雰囲気ガスに含有する水分は、露点で-30℃以下であることが好ましい。これ以上の水分を含有する場合、焼結時にAlNが雰囲気ガス中の水分と反応して酸窒化物が形成されるので、熱伝導率が低下する可能性がある。また、雰囲気ガス中の酸素量は、0.001vol%以下であることが好ましい。酸素量が多いと、AlNの表面が酸化して、熱伝導率が低下する可能性がある。

【 0 0 3 0 】

更に、焼結時に使用する治具は、窒化ホウ素(BN)成形体が好適である。このBN成形体は、前記焼結温度に対し十分な耐熱性を有するとともに、その表面に固体潤滑性があるので、焼結時に積層体が収縮する際の治具と積層体との間の摩擦を小さくすることができるので、歪みの少ない焼結体を得ることができる。

【 0 0 3 1 】

得られた焼結体は、必要に応じて加工を施す。次工程の導電ペーストをスクリーン印刷する場合、焼結体の表面粗さは、Raで5μm以下であることが好ましい。5μmを超えるとスクリーン印刷により回路形成した際に、パターンのにじみやピンホールなどの欠陥が発生しやすくなる。表面粗さはRaで1μm以下であればさらに好適である。

【 0 0 3 2 】

上記表面粗さを研磨加工する際には、焼結体の両面にスクリーン印刷する場合は当然であるが、片面のみにスクリーン印刷を施す場合でも、スクリーン印刷する面と反対側の面も研磨加工を施す方がよい。スクリーン印刷する面のみを研磨加工した場合、スクリーン印刷時には、研磨加工していない面で焼結体を支持することになる。その時、研磨加工していない面には突起や異物が存在することがあるので、焼結体の固定が不安定になり、スクリーン印刷で回路パターンがうまく描けないことがあるからである。

【 0 0 3 3 】

また、この時、両加工面の平行度は0.5mm以下であることが好ましい。平

行度が0.5 mmを超えるとスクリーン印刷時に導電ペーストの厚みのバラツキが大きくなることがある。平行度は0.1 mm以下であれば特に好適である。さらに、スクリーン印刷する面の平面度は、0.5 mm以下であることが好ましい。0.5 mmを超える平面度の場合にも、導電ペーストの厚みのバラツキが大きくなることがある。平面度も0.1 mm以下であれば特に好適である。

【0034】

研磨加工を施した焼結体に、スクリーン印刷により導電ペーストを塗布し、電気回路の形成を行う。導電ペーストは、金属粉末と必要に応じて酸化物粉末と、バインダーと溶剤を混合することにより得ることができる。金属粉末は、セラミックスとの熱膨張係数のマッチングから、タングステンやモリブデンあるいはタンタルが好ましい。

【0035】

また、AlNとの密着強度を高めるために、酸化物粉末を添加することもできる。酸化物粉末は、IIa族元素やIIIIa族元素の酸化物や Al_2O_3 、 SiO_2 などが好ましい。特に、酸化イットリウムはAlNに対する濡れ性が非常に良好であるので、好ましい。これらの酸化物の添加量は、0.1~30 wt %が好ましい。0.1 wt %未満の場合、形成した電気回路である金属層とAlNとの密着強度が低下する。また30 wt %を超えると、電気回路である金属層の電気抵抗値が高くなる。

【0036】

導電ペーストの厚みは、乾燥後の厚みで、5 μm 以上、100 μm 以下であることが好ましい。厚みが5 μm 未満の場合は、電気抵抗値が高くなりすぎるとともに、密着強度も低下する。また、100 μm を超える場合も、密着強度が低下する。

【0037】

また、形成する回路パターンが、ヒータ回路（抵抗発熱体回路）の場合は、パターンの間隔は0.1 mm以上とすることが好ましい。0.1 mm未満の間隔では、抵抗発熱体に電流を流したときに、印加電圧及び温度によっては漏れ電流が発生し、ショートする。特に、500℃以上の温度で使用する場合には、パター

ン間隔は 1 mm 以上とすることが好ましく、3 mm 以上であれば更に好ましい。

【 0 0 3 8 】

次に、導電ペーストを脱脂した後、焼成する。脱脂は、窒素やアルゴン等の非酸化性雰囲気中で行う。脱脂温度は 5 0 0 °C 以上が好ましい。5 0 0 °C 未満では、導電ペースト中のバインダーの除去が不十分で金属層内にカーボンが残留し、焼成したときに金属の炭化物を形成するので、金属層の電気抵抗値が高くなる。

【 0 0 3 9 】

焼成は、窒素やアルゴンなどの非酸化性雰囲気中で、1 5 0 0 °C 以上の温度で行うのが好適である。1 5 0 0 °C 未満の温度では、導電ペースト中の金属粉末の粒成長が進行しないので、焼成後の金属層の電気抵抗値が高くなり過ぎる。また、焼成温度はセラミックスの焼結温度を超えない方がよい。セラミックスの焼結温度を超える温度で導電ペーストを焼成すると、セラミックス中の含有する焼結助剤などが揮散しはじめ、更には導電ペースト中の金属粉末の粒成長が促進されてセラミックスと金属層との密着強度が低下する。

【 0 0 4 0 】

次に、形成した金属層の絶縁性を確保するために、金属層の上に絶縁性コートを形成することができる。絶縁性コートの材質は、金属層が形成されているセラミックスと同じ材質であることが好ましい。該セラミックスと絶縁性コートの材質が大幅に異なると、熱膨張係数の差から焼結後に反りが発生するなどの問題が生じる。例えば、AlN の場合、AlN 粉末に焼結助剤として所定量の II a 族元素あるいは III a 族元素の酸化物や炭酸化物を加え、混合し、これにバインダーや溶剤を加え、ペーストとして、該ペーストをスクリーン印刷により、前記金属層の上に塗布することができる。

【 0 0 4 1 】

この時、添加する焼結助剤量は、0. 0 1 w t % 以上であることが好ましい。0. 0 1 w t % 未満では、絶縁性コートが緻密化せず、金属層の絶縁性を確保することが困難となる。また、焼結助剤量は 2 0 w t % を超えないことが好ましい。2 0 w t % を超えると、過剰の焼結助剤が金属層中に浸透するので、金属層の電気抵抗値が変化してしまうことがある。塗布する厚みに特に制限はないが、5

μm 以上であることが好ましい。 $5\mu\text{m}$ 未満では、絶縁性を確保することが困難となるからである。

【0042】

次に、必要に応じて更にセラミックス基板を積層することができる。積層は、接合剤を介して行うのが良い。接合剤は、酸化アルミニウム粉末や窒化アルミニウム粉末に、I I a 族元素化合物やI I I a 族元素化合物とバインダーや溶剤を加え、ペースト化したものを接合面にスクリーン印刷等の手法で塗布する。塗布する接合剤の厚みに特に制約はないが、 $5\mu\text{m}$ 以上であることが好ましい。 $5\mu\text{m}$ 未満の厚みでは、接合層にピンホールや接合ムラ等の接合欠陥が生じやすくなる。

【0043】

接合剤を塗布したセラミックス基板を、非酸化性雰囲気中、 500°C 以上の温度で脱脂する。その後、積層するセラミックス基板を重ね合わせ、所定の荷重を加え、非酸化性雰囲気中で加熱することにより、セラミックス基板同士を接合する。荷重は、 $0.05\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上であることが好ましい。 $0.05\text{kg}/\text{cm}^2$ 未満の荷重では、十分な接合強度が得られないか、もしくは前記接合欠陥が生じやすい。

【0044】

接合するための加熱温度は、セラミックス基板同士が接合層を介して十分密着する温度であれば、特に制約はないが、 1500°C 以上であることが好ましい。 1500°C 未満では、十分な接合強度が得られにくく、接合欠陥を生じやすい。前記脱脂ならびに接合時の非酸化性雰囲気は、窒素やアルゴンなどを用いることが好ましい。

【0045】

以上のようにして、ウェハ保持体となるセラミックス積層焼結体を得ることができる。なお、電気回路は、導電ペーストを用いずに、例えば、ヒータ回路であれば、モリブデン線（コイル）、静電吸着用電極やRF電極などの場合には、モリブデンやタングステンのメッシュ（網状体）を用いることも可能である。

【0046】

この場合、A 1 N原料粉末中に上記モリブデンコイルやメッシュを内蔵させ、ホットプレス法により作製することができる。ホットプレスの温度や雰囲気は、前記A 1 Nの焼結温度、雰囲気に準ずればよいが、ホットプレス圧力は、 10 kg/cm^2 以上加えることが望ましい。 10 kg/cm^2 未満では、モリブデンコイルやメッシュとA 1 Nの間に隙間が生じることがあるので、ウェハ保持体の性能が出なくなることがある。

【0047】

次に、コファイア法について説明する。前述した原料スラリーをドクターブレード法によりシート成形する。シート成形に関して特に制約はないが、シートの厚みは、乾燥後で3 mm以下が好ましい。シートの厚みが3 mmを超えると、スラリーの乾燥収縮量が大きくなるので、シートに亀裂が発生する確率が高くなる。

【0048】

上述したシート上に所定形状の電気回路となる金属層を、導体ペーストをスクリーン印刷などの手法により塗布することにより形成する。導電ペーストは、ポストメタライズ法で説明したものと同一ものを用いることができる。ただし、コファイア法では、導電ペーストに酸化物粉末を添加しなくても支障はない。

【0049】

次に、回路形成を行ったシート及び回路形成をしていないシートを積層する。積層の方法は、各シートを所定の位置にセットし、重ね合わせる。この時、必要に応じて各シート間に溶剤を塗布しておく。重ね合わせた状態で、必要に応じて加熱する。加熱する場合、加熱温度は、 150°C 以下であることが好ましい。これを超える温度に加熱すると、積層したシートが大きく変形する。そして、重ね合わせたシートに圧力を加えて一体化する。加える圧力は、 $1\sim 100\text{ MPa}$ の範囲が好ましい。 1 MPa 未満の圧力では、シートが充分に一体化せず、その後の工程中に剥離することがある。また、 100 MPa を超える圧力を加えると、シートの変形量が大きくなりすぎる。

【0050】

この積層体を、前述のポストメタライズ法と同様に、脱脂処理並びに焼結を行

う。脱脂処理や焼結の温度や、炭素量等はポストメタライズ法と同じである。前述した、導電ペーストをシートに印刷する際に、複数のシートにそれぞれヒータ回路や静電吸着用電極等を印刷し、それらを積層することで、複数の電気回路を有するウェハ保持体を容易に作成することも可能である。このようにして、ウェハ保持体となるセラミックス積層焼結体を得ることができる。

【 0 0 5 1 】

得られたセラミックス積層焼結体は、必要に応じて加工を施す。通常、焼結した状態では、半導体製造装置で要求される精度に入らないことが多い。加工精度は、例えば、ウェハ搭載面の平面度は0.5 mm以下が好ましく、さらには0.1 mm以下が特に好ましい。平面度が0.5 mmを超えると、ウェハーとウェハ保持体との間に隙間が生じやすくなり、ウェハ保持体の熱がウェハに均一に伝わらなくなり、ウェハの温度ムラが発生しやすくなる。

【 0 0 5 2 】

また、ウェハ搭載面の面粗さは、Raで5 μ m以下が好ましい。Raで5 μ mを超えると、ウェハ保持体とウェハとの摩擦によって、A1 Nの脱粒が多くなることがある。この時、脱粒した粒子はパーティクルとなり、ウェハ上への成膜やエッチングなどの処理に対して悪影響を与えることになる。さらに、表面粗さは、Raで1 μ m以下であれば、好適である。

【 0 0 5 3 】

以上のようにして、ウェハ保持体本体を作製することができる。さらに、このウェハ保持体にシャフトを取り付ける。シャフトの材質は、ウェハ保持体のセラミックスの熱膨張係数と大きく違わない熱膨張係数のものであれば特に制約はないが、ウェハ保持体との熱膨張係数の差が 5×10^{-6} /K以下であることが好ましい。

【 0 0 5 4 】

熱膨張係数の差が、 5×10^{-6} /Kを超えると、取付時にウェハ保持体とシャフトの接合部付近にクラックなどが発生したり、接合時にクラックが発生しなくても、繰り返し使用しているうちに接合部に熱サイクルが加わり、割れやクラックが発生することがある。例えば、ウェハ保持体がA1 Nの場合、シャフトの

材質は、 AlN が最も好適であるが、窒化珪素や炭化珪素あるいはムライト等が使用できる。

【0055】

取付は、接合層を介して接合する。接合層の成分は、 AlN 及び Al_2O_3 並びに希土類酸化物からなることが好ましい。これらの成分は、ウェハ保持体やシャフトの材質である AlN などのセラミックスと濡れ性が良好であるので、接合強度が比較的高くなり、また接合面の気密性も得られやすいので好ましい。

【0056】

接合するシャフト並びにウェハ保持体それぞれの接合面の平面度は 0.5 mm 以下であることが好ましい。これを超えると接合面に隙間が生じやすくなり、十分な気密性を持つ接合を得ることが困難となる。平面度は 0.1 mm 以下がさらに好適である。なお、ウェハ保持体の接合面の平面度は 0.02 mm 以下であればさらに好適である。また、それぞれの接合面の面粗さは、 Ra で $5\text{ }\mu\text{ m}$ 以下であることが好ましい。これを超える面粗さの場合、やはり接合面に隙間が生じやすくなる。面粗さは、 Ra で $1\text{ }\mu\text{ m}$ 以下がさらに好適である。

【0057】

次に、ウェハ保持体に電極を取り付ける。取付は、公知の手法で行うことができる。例えば、ウェハ保持体のウェハ保持面と反対側から電気回路までザグリ加工を施し、電気回路にメタライズを施すかあるいはメタライズなしで直接活性金属ろうを用いて、モリブデンやタングステン等の電極を接続すればよい。その後必要に応じて電極にメッキを施し、耐酸化性を向上させることができる。このようにして半導体製造装置用ウェハ保持体を作製することができる。

【0058】

また、本発明のウェハ保持体を半導体装置に組み込んで、半導体ウェハを処理することができる。本発明のウェハ保持体は、ウェハ保持面の温度が均一であるので、ウェハの温度分布も従来より均一になるので、形成される膜や熱処理等に対して、安定した特性を得ることができる。

【0059】

【実施例】

実施例 1

99 重量部の窒化アルミニウム粉末と 1 重量部の Y_2O_3 粉末を混合し、ポリビニルブチラールをバインダー、ジブチルフタレートを溶剤として、それぞれ 10 重量部、5 重量部混合して、ドクターブレード法にて直径 430 mm、厚さ 1.0 mm のグリーンシートを成形した。なお、窒化アルミニウム粉末は、平均粒径 $0.6 \mu m$ 、比表面積 $3.4 m^2/g$ のものを使用した。また、平均粒径が $2.0 \mu m$ の W 粉末を 100 重量部として、 Y_2O_3 を 1 重量部と、5 重量部のバインダーであるエチルセルロースと、溶剤としてブチルカルビトールを用いて W ペーストを作製した。混合にはポットミルと三本ロールを用いた。この W ペーストをスクリーン印刷で、前記グリーンシート上に、ヒータ回路パターンを形成した。

【0060】

ヒータ回路を印刷したグリーンシートに、別の 1.0 mm 厚のグリーンシートを複数積層し、積層体を作製した。積層はモールドにシートを重ねてセットし、プレス機にて $50^\circ C$ に熱しつつ、10 MPa の圧力で 2 分間熱圧着することで行った。その後、窒素雰囲気中で $600^\circ C$ にて脱脂を行い、窒素雰囲気中で $1800^\circ C$ 、3 時間の条件で焼結を行いウェハ保持体を作製した。なお、焼結後、ウェハ保持面は Ra で $1 \mu m$ 以下に、シャフト接合面は Ra で $5 \mu m$ 以下になるよう研磨加工を施した。また外径も仕上加工を行った。加工後のウェハ保持体の寸法は、外径 340 mm で、厚みは 16 mm である。

【0061】

次に、ウェハ保持面とは反対側の面に、外径 80 mm、内径 60 mm、長さ 300 mm の AlN 製のシャフトを取り付けた。接合剤は、50% Al_2O_3 - 30% Y_2O_3 - 20% AlN である。シャフトの外径が、80 mm であり、ウェハ保持体の厚みが 16 mm であるので、ウェハ保持体のシャフトに相当する部分の熱容量は、 $53.88 J/gK$ となる。

【0062】

ウェハ保持面の反対側の面から、前記ヒータ回路までザグリ加工を行い、ヒータ回路を一部露出させた。露出したヒータ回路部に Mo 製の電極を活性金属ろう

を用いて直接接合した。この電極に通電することによりウェハ保持体を加熱し、均熱性を測定した。なお、電極の直径は4 mmで、長さは300 mmとした。また、表1に示す本数の電極を取り付けた。

【0063】

均熱性の測定は、12インチウェハ温度計をウェハ保持面に搭載し、その温度分布を測定した。なお、ウェハ温度計の中心部の温度が550℃になるように、供給電力を調整した。この結果を、表1に示す。なお、電極の総熱容量を、電極熱容量として、またシャフト部分に相当するウェハ保持体の熱容量との比率を、熱容量比として、表1にあわせて示す。

【0064】

【表1】

No	電極本数	電極熱容量 (J/g K)	熱容量比 (%)	均熱性 (%)
1	2	1.01	1.8	±0.36
2	4	2.02	3.7	±0.43
3	6	3.03	5.6	±0.51
4	8	4.04	7.5	±0.74
5	10	5.05	9.3	±0.85

【0065】

実施例2

実施例1と同様にして外径340 mmで厚さ19 mmのAlN製ウェハ保持体を作製した。このウェハ保持体の実施例1と同じAlN製シャフトを実施例1と同様にして取付けた。ウェハ保持体の厚さを19 mmとしたので、ウェハ保持体のシャフトに相当する部分の熱容量は、63.98 J/g Kである。更に、実施例1と同様に表2に示す本数の電極を取付け、550℃での温度分布を実施例1と同様に測定した。その結果を表2に示す。

【0066】

【表 2】

N o	電極本数	電極熱容量 (J / g K)	熱容量比 (%)	均熱性 (%)
6	2	1. 0 1	1. 5	± 0. 3 5
7	4	2. 0 2	3. 1	± 0. 3 9
8	6	3. 0 3	4. 7	± 0. 4 8
9	8	4. 0 4	6. 3	± 0. 6 8
1 0	1 0	5. 0 5	7. 8	± 0. 7 5

【 0 0 6 7 】

実施例 3

実施例 1 と同様にして外径 3 4 0 m m で厚さ 1 9 m m の A 1 N 製ウェハ保持体を作製した。このウェハ保持体に実施例 1 と同じ A 1 N 製のシャフトを実施例 1 と同様にして取付けた。更に、実施例 1 と同様に表 3 に示す外径と本数の電極を取付け、5 5 0 ℃での温度分布を実施例 1 と同様に測定した。その結果を表 3 に示す。

【 0 0 6 8 】

【表 3】

N o	電極外径 (mm)	電極本数	電極熱容量 (J / g K)	熱容量比 (%)	均熱性 (%)
1 1	8	2	4. 0 4	6. 3	± 0. 6 2
1 2	8	4	8. 0 8	1 2. 6	± 1. 2 6
1 3	8	6	1 2. 1 2	1 8. 9	± 2. 9 2
1 4	1 2	2	9. 0 9	1 4. 2	± 1. 6 9
1 5	1 2	4	1 8. 1 8	2 8. 4	± 3. 8 8
1 6	1 2	6	2 7. 2 7	4 2. 6	± 5. 3 5

【 0 0 6 9 】

表 1 ～ 3 から判るように、シャフト内における電極の熱容量を、ウェハ保持体

のシャフトに相当する部分の熱容量の 1 0 % 以下とすることにより、ウェハ表面の温度分布を $\pm 1 \%$ 以内にする事ができる。更に、電極の熱容量をウェハ保持体のシャフトに相当する部分の熱容量の 5 % 以下とすれば、ウェハ表面の温度分布を $\pm 0.5 \%$ 以内にする事ができる。

【 0 0 7 0 】

実施例 4

表 1 ～ 3 の各ウェハ保持体を半導体製造装置に組み込み、直径 1 2 インチの S i ウェハの上に、T i N 膜を形成した。N o. 1 2 ～ 1 6 のウェハ保持体を用いた場合は、T i N の膜厚のバラツキが 1 5 % 以上と大きかったが、それ以外のウェハ保持体を用いた場合は、1 0 % 以下と膜厚のバラツキが小さく、良好な T i N 膜を形成することができた。

【 0 0 7 1 】

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、シャフト内における電極の熱容量を、ウェハ保持体のシャフトの外周部内に相当する部分の熱容量の 1 0 % 以下とすることにより、均熱性に優れたウェハ保持体及び半導体製造装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明のウェハ保持体の断面構造の一例を示す。

【図 2】 図 1 のウェハ保持体の下面側平面図である。

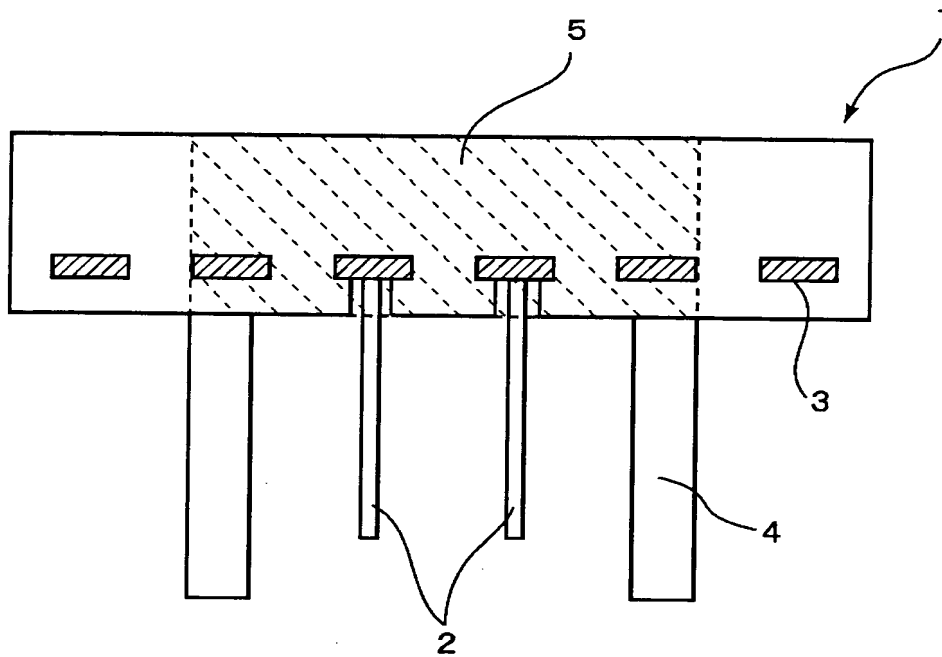
【符号の説明】

- 1 ウェハ保持体
- 2 電極
- 3 抵抗発熱体
- 4 シャフト
- 5 ウェハ保持体のシャフトの外周部内に相当する部分

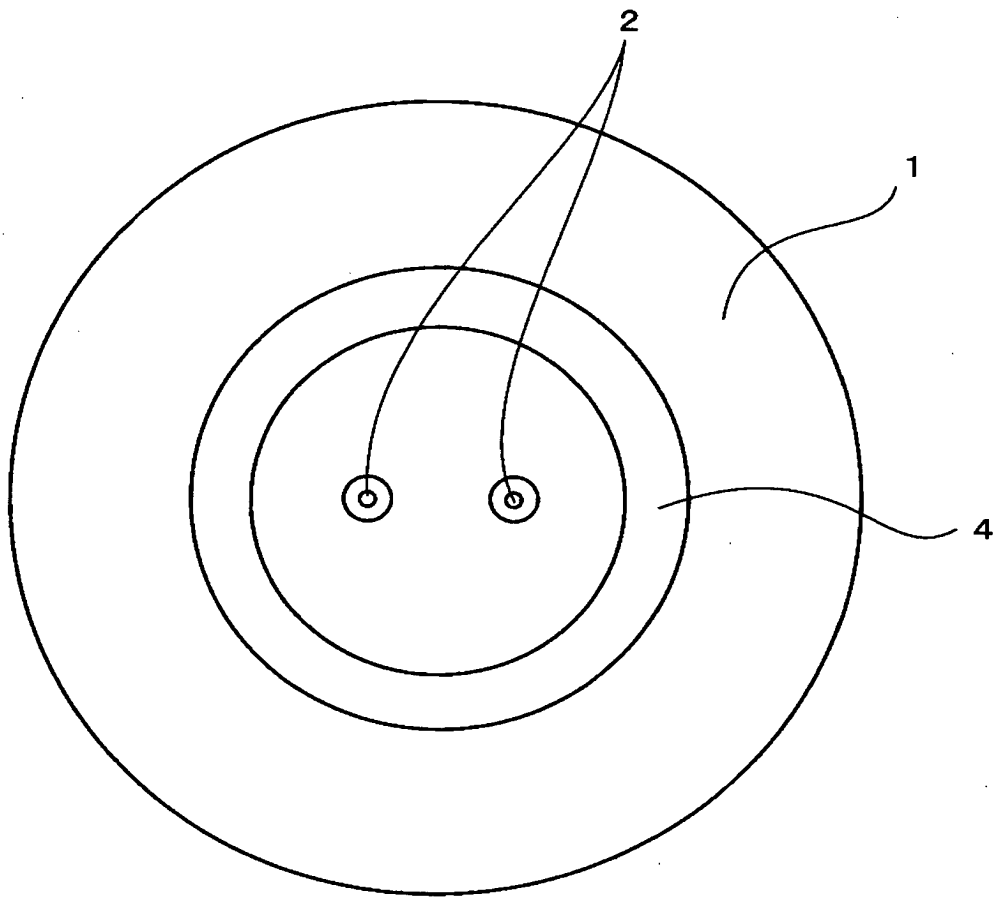
【書類名】

図面

【図 1】



【図2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ウェハ搭載面を有するウェハ保持体のウェハ保持面の均熱性を高めた半導体製造用ウェハ保持体およびそれを搭載した半導体製造装置を提供する。

【解決手段】 ウェハ搭載面を有するウェハ保持体において、前記ウェハ保持体を支持するシャフトが前記ウェハ保持体に接合されており、前記ウェハ保持体のウェハ搭載面以外の表面もしくは内部に形成された電気回路に給電するための電極の前記シャフト内における熱容量が、前記ウェハ保持体のシャフトの外周部内に相当する部分の熱容量の10%以下にすれば、ウェハ保持面の温度分布を±1.0%以内にすることができる。前記ウェハ保持体に形成された電気回路は、少なくとも抵抗発熱体であることが望ましい。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-064279
受付番号	50300389215
書類名	特許願
担当官	第四担当上席 0093
作成日	平成15年 3月12日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年 3月11日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002130]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

氏 名 住友電気工業株式会社